



8050 引脚图



芯片尺寸：4 英寸（100mm）

芯片代码：C060AJ-00

芯片厚度：240±20μm

管芯尺寸：600×600μm<sup>2</sup>

焊位尺寸：B 极 130×150μm<sup>2</sup>；E 极 140×130μm<sup>2</sup>

电极金属：铝

背面金属：金

典型封装：S8050，H8050

极限值（Ta=25℃）（封装形式：TO-92）

Tstg——贮存温度 -55~150℃

Tj——结温 150℃

PC——集电极耗散功率 1W

VCBO——集电极—基极电压 40V

VCEO——集电极—发射极电压 25V

VEBO——发射极—基极电压 6V

IC——集电极电流 1.2A

电参数（Ta=25℃）（封装形式：TO-92）

参数符号	符号说明	最小值	典型值	最大值	单位	测试条件
$I_{ce0}$	集电极—基极截止电流			0.1	μA	$V_{ce}=10V, I_b=0$
$I_{be0}$	发射极—基极截止电流			0.1	μA	$V_{be}=4V, I_c=0$
$I_{cm}$	直流电流增益	20		100		$V_{ce}=1V, I_c=100\mu A$
		40				$V_{ce}=1V, I_c=100\mu A$
$V_{be(sat)}$	基极—发射极饱和电压			1.0	V	$V_{ce}=1V, I_c=100\mu A$
$V_{ce(sat)}$	集电极—发射极饱和电压			0.5	V	$I_c=100\mu A, I_b=100\mu A$
$V_{be(off)}$	基极—发射极截止电压			1.1	V	$I_c=100\mu A, I_b=100\mu A$
$h_{FE}$	集电极—基极直流电流增益	40			V	$I_c=100\mu A, I_b=0$
$h_{FE}$	集电极—发射极直流电流增益	20			V	$I_c=100\mu A, I_b=0$
$h_{FE}$	发射极—基极直流电流增益	8			V	$I_c=100\mu A, I_b=0$
$f_T$	特征频率	100			kHz	$V_{ce}=10V, I_c=100\mu A$

更多资讯欢迎咨询：18042865818